

TL Sm

1914

V 498

Korreng

Neues Jahrb. Mineral. Geol. Beilage
1914, Bd. 37, 76

^{QZ}
 $\text{TlCl} \cdot \text{SnCl}_2$, 3TlPnCl_2 , $\text{TlCl} \cdot 2\text{PbCl}_2$,

$3\text{TlCl} \cdot \text{PbCl}_2$, ZnCl_2 , $2\text{TlCl} \cdot \text{ZnCl}_2$,

$\text{TlCl}_2 \cdot 2\text{ZnCl}_2$, CdCl_2 (Tm)

Be

F

E.C.T., 3. H.

J 498 1914

Korrenz

Neues Jahrb. Mineral. Geol. Beilage

1914, Bd. 37, T 6

EOSTR. S. 14.

TlCl, SnCl₂; 3TlSnCl₂; TlCl. 2PbCl₂;

3TlCl. PbCl₂;

~~ZnCl₂~~ ZnCl₂;

2TlCl. ZnCl₂; TlCl₂. 2ZnCl₂;

CdCl₂ (Tm)

5 (cp)

c. 500

11

V 6574

1961

$\delta n T_{lx}$ (T_{tr})

Schüirmann E., Oberle B.

Arch. Eisenhüttenwesen, 1961, 32, NII, 791

A1

PMEK, 1962, 196282

V4641

7465

Tl - Sn p-p (ΔG_m , ΔS_{mix} , ΔH_{mix})

Strozeska K., Terpilowski J.,

Roczniki Chem., 1965, 39, №5, 663-668

Thermodynamic properties of thallium tin liquid solutions.

w

CA, 1965, 63, №10, 12406c

Te - Sn

a b c

BPF-8000¹⁹⁶⁶

Nozato Ryoichi, Oshio Eisei, Hagiwara Hisato.

Bull. Univ. Osaka Prefect., 1966, A15, N1, 137-151
(an21.).

The constitution of tin-thallium alloys.

PAK, 1967 N12(I) 126645.

φ II.

1969

У5602
TlCl₂S_nCl₂ (Tm)

Абшногенов Ю.П., Лемеш А.Д.,

Ж. неорган. химии, 1967, 12, № 6, 1705

Система

TlS_nCl₅

РБХ., 1967, 21Б755

Б Ф

Snee, TCC

1973.

Wojakowska et alia
et al

Tm, atm

Entered 1945

"Racz, Chen"

1973, 47, n9,
1621-27.

(See SIR-CB, i)

[Ottawa 1945]

1973

2. $\text{SnBr}_2 \cdot \text{TlBr}$ Enthalpies of fusion
of some simple and binary tin
(II) compounds.

(ΔH_f)

Wojakowska, Alina

Roczn. Chem., 1973, 47(9) 1621-7

(Eng.)



(all $\text{SnCl}_2 \cdot \text{I}$)

$\text{SnCl}_2 \cdot \text{TlCl}$; $2\text{SnBr}_2 \cdot \text{TlBr}$ 1974

u.g.p.

(Tm)

116784f Phase diagrams of tin(II) chloride-thallium(I) chloride and tin(II) bromide-thallium(I) bromide systems. Terpilowski, Janusz; Wojakowska, Alina (Inst. Chem. Chem. Technol. Med. Prod., Sch. Med., Wroclaw, Pol.). *Roczn. Chem.* 1974, 48(11), 1877-81 (Eng). Examn. of phase diagrams revealed the existence of the following compds.: $\text{SnCl}_2 \cdot \text{TlCl}$ m. 258.0° , $2\text{SnCl}_2 \cdot \text{TlCl}$ m. 209.4° , $\text{SnCl}_2 \cdot 3\text{TlCl}$ m. 320° , and $7\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{TlCl}$ m. 197.0° . The latter compds. melted incongruently. The eutectic points were at 19.0 mole % TlCl , m. 195.2° and at 1 mole % TlCl m. 254.3° . The SnBr_2 - TlBr system was characterized by the existence of a compd. $2\text{SnBr}_2 \cdot \text{TlBr}$ m. congruently at 290.0° , and $\text{SnBr}_2 \cdot 3\text{TlBr}$ and $4\text{SnBr}_2 \cdot 5\text{TlBr}$ m. incongruently at 339.1 and 273.7° , resp. Eutectic points corresponding to 6.3 and 48.1 mole % TlBr occur at 220.5 and 268.0° , resp. I. Kloczko

C.A. 1975, 82 n 18

Tl_2SnSe_3

XV-3408

1976

Tl_4SnSe_4

86: 128141q Study of the tin(IV) selenide-thallium(I) selenide system. Houenou, Pascal; Eholie, Rose (Lab. Chim. Miner., Fac. Sci., Abidjan, Ivory Coast). *C. R. Hebdo. Seances Acad. Sci., Ser. C* 1976, 283(16), 731-3 (Fr). DTA and x-ray studies of the system $SnSe_2-Tl_2Se$ reveal 3 compds. Tl_2SnSe_3 is stable between 375° and its peritectic decompr. at 460°, Tl_2SnSe_3 congruently m. 472°, and Tl_4SnSe_4 incongruently m. 425°. Tl_2SnSe_3 is tetragonal, space group $P4_22_12$, with a 5.74 and c 21.31 Å. X-ray powder data are given for all 3 compds.

A. W. Nicol

(T_m)

C.R. 1977, 86
N18

Tl_xSnSe₃

XV-3408.

1976

13 Б842. Исследование системы SnSe₂—Tl₂Se.
Ноуэлл Pascal, Eholté Rose. Etude du système
SnSe₂—Tl₂Se. «C. r. Acad. sci.», 1976, C 283, № 16,
731—733 (франц.; рез. англ.)

Система SnSe₂(I)—Tl₂Se(II) изучена методами рентгенофографии (порошка и Вейссенберга) и ДТА на образцах, полученных на основе смесей либо I и II, либо простых в-в, причем смеси нагревали в течение нескольких дней при 600°, затем отжигали при 300—450° и подвергали закалке. В системе обнаружены 3 фазы: Tl₂SnSe₃(III), Tl₄SnSe₄(IV) и Tl₂Sn₂Se₅(V). III плавится при 472° конгруэнтно, но с очень плоским максимумом на кривой ликвидуса. IV перитектически разлагается при 425°. V устойчиво в узком интервале т-р, образуется в результате эвтектоидной р-ции и перитектически разлагается при 460°. Между I и V имеется эвтектика при 455° и ат. отношении $n = \text{Tl}/(\text{Tl} + \text{Sn}) = 0,48$. Вторая эвтектика между IV и II соответствует $n = 0,90$. III имеет тетрагональную решетку с параметрами $a = 5,74$; $c = 21,31$ Å, $\rho(\text{выч.}) = 7,23$ г/см³, пространственная группа $P4_22_12$. Для IV и V приведены межплоскостные расстояния.

И. Н. Семенов

*Изучение
системы*

(Tm)

Х. 1977. № 13

Tl - Sn - Sb (concent)

1976

measured
cb-ber

86: 34944b Thermodynamic properties of liquid alloys of the thallium-tin-antimony system along the $N_{\text{Sb}}:N_{\text{Sn}} = 3$ section line. Mamedov, A. N.; Kulieva, N. A.; Asadov, M. V. (Azerb. Gos. Univ. im. Kirova, Baku, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1976, 50(8), 2175 (Russ). The partial thermodyn. functions of Tl at 750 K were detd. from emf. measurements on concn. cells at 400-600°C, $N_{\text{Tl}} = 0.1-0.8$ and $N_{\text{Sb}}:N_{\text{Sn}} = 3$. The exptl. detd. activities of Tl were in agreement with values calcd. from the data for the binary systems using Toop's equation. The integrated thermodyn. functions for the Tl-Sn-Sb alloys were calcd. from the data for Sn-Sb alloys using Darken's equation: $\Delta F_{\text{excess}} = -2680 (1-N_{\text{Tl}}) + 2530 (1-N_{\text{Tl}})^{1.5}$ and $\Delta H = -3476 (1-N_{\text{Tl}}) + 3380 (1-N_{\text{Tl}})^{1.3}$ cal/g. atom.

P. K. Ra

C.A. 1977 86 . 6

1977



pazob.
guzarh.

89: 80872m Study of the thallium selenide(Tl_2Se)-tin selenide($SnSe_2$) system. Gotuk, Ali Alarik; Babanly, M. B.; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Azerb. Khim. Zh.* 1977, (6), 128-30 (Russ). A complex interaction between the components of the system occurs at 33.3-75 mol % $SnSe_2$. Formation of Tl_4SnSe_4 and Tl_2SnSe_3 was confirmed. Thermal effects were obsd. in heterogeneous melts consisting of the 4-phase mixts. $Tl_2SnSe_3-TlSnSe_2-SnSe_2-Se$. The system was studied by DTA, x-ray phase anal., and microhardness methods.

C.A. 1978, 89, N10

Tl - Sb - Sn (cubic)

1977

87: 157922w Thermodynamic study of thallium-tin-antimony system molten alloys. Pashinkin, A. S.; Mamedov, A. N.; Kulieva, N. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). Azerb. Khim. Zh. 1977, (1), 109-13 (Russ). The thermodn. properties of the liq. alloys were detd. at $N_{Sb}:N_{Sb}$ ratios 1:3, 1, and 3 by the emf. method. The applicability of various calcn. methods to predict partial and integral equations was investigated. Data calcd. for the sections $N_{Sb}:N_{Sb}$ 3 and $N_{Sb}:N_{Sb}$ 3 of the ternary alloys agreed with the exptl. data.

C.A. 1977, 87, 220

SnI₂.TlI

1977

SnI₂.TlI

88: 111260w Phase diagram of the tin(II) iodide-thallium(I) iodide system. Wojakowska, Alina (Inst. Chem. Chem. Technol. Med. Prod., Sch. Med., Wroclaw, Pol.). *Roczniki Chem.* 1977, 51(12), 2307-13 (Eng). The phase diagram was constructed from cooling curves. The pure components m. 321.8 (SnI₂) and 442.2° (TlI). The system contains 2 binary compds.: 2SnI₂.TlI and SnI₂.TlI congruently m. 307.7 and 292.7°, resp., and a compd. SnI₂.3TlI incongruently m. 329.7°. Three eutectic points occur at 16.30, 46.90, and 56.50 mol % TlI and 298.2, 292.2, and 288.1°, resp. A comparison of the systems SnCl₂-TlCl and SnBr₂-TlBr is presented and a method for obtaining anhyd. SnI₂ (free from O and Sn(IV)) is given. I. Kloczko

Tm

C.A. 1978, 88, 1116

Tl₂Se-SnSe

1978

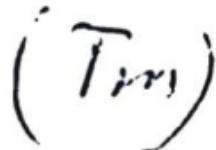
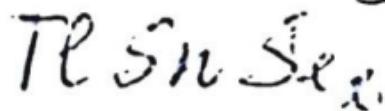
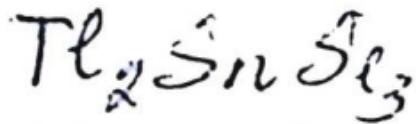
Tl₂Se-PbSe

88: 159324x Phase equilibria in thallium selenide-tin selenide (Tl₂Se-SnSe) and thallium selenide-lead selenide (Tl₂Se-PbSe) systems. Gotuk, Ali Alarik; Babanly, M. B.; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1978, 14(3), 587-8 (Russ). The title systems were studied by microhardness, DT'A, and x-ray phase anal. methods. Both systems contain Tl₂Se-based solid solns. formed by peritectic reaction. Max. solubilities are SnSe ~12 and PbSe ~37 mol % at the peritectic temps. 400, 545°, resp. A eutectoid transition occurs at SnSe 92 mol % and 480°.

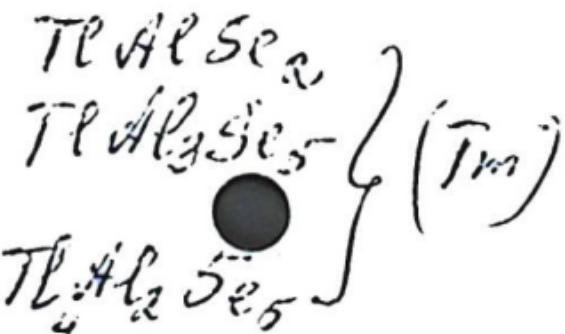
perovskite
quartzite

C.A. 1978, 82, 1422

1973

(4-1)

92: 29183x Study of thallium selenide-tin selenide ($\text{Tl} = \text{Se-SnSe}$) and thallium selenide-aluminum selenide ($\text{Tl} = \text{Se-Al}_2\text{Se}_3$) systems. Kuliev, A. A.; Kagramanyan, Z. G. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Azerb. Khim. Zh.* 1978, (4), 113-16 (Russ). The system TlSe-SnSe contains Tl_2SnSe_3 and TlSnSe_2 , incongruently m. at 380 and 490°, resp.; the $\text{Tl}_2\text{Se-Al}_2\text{Se}_3$ system contains TlAlSe_2 (I) and TlAl_3Se_5 (II), congruently m. at 856 and 831°, resp., and $\text{Tl}_4\text{Al}_2\text{Se}_5$ incongruently m. at 360°. I and II are monoclinic brown-red and tetragonal yellow crystals, resp. The phase diagrams of these systems were detd. by DTA, x-ray phase anal., and microstructural anal.



C.A. 1980, 92, 114

1979



grayish
fibroscopic

91: 199659d Phase equilibria in a thallium-tin-tellurium system. Alarik, Gotuk Ali; Babanly, M. B.; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1979, 15(8), 1356-61 (Russ). The 25 ° isotherm and polythermal sections Tl_2Te - $SnTe$, Tl_5Te_3 - $SnTe$, $TlTe$ - $SnTe$, Tl_5Te_3 - Tl_4SnTe_3 , and Tl_4SnTe_3 - Sn were constructed from DTA, microhardness, and x-ray phase anal. data. The liquidus surface shows formation of Tl_4SnTe_3 and Tl_2SnTe_3 . Invariant points occur at 295, 215 (peritectic), and 210 ° (eutectic) and Tl 40, 29, 25.5 and Sn 2.5, 2.5, 4.5 at. %, resp. Lattice parameters for tetragonal Tl_4SnTe_3 are $a = 8.98$, $c = 12.41$ Å.

C. H. 1979, 9, 124

XV - 3692

1148

Tl_xSnS₃

3 Б827. Термодинамическое исследование системы Tl—Sn—S методом э. д. с. Бабанлы М. Б., Готук Али Аларик, Кулев А. А. «8-я Всес. конф. по калориметрии и хим. термодинам., Иваново, 1979. Тез. докл. II-ПКТБМ», Иваново, 1979, 342

В интервале т-р 300—430 К измерены э. д. с. концентрац. цепей типа Tl(тв.) | глицерин+KCl+TlCl | (Tl^xSn_y-S_{1-x-y}) (тв.). С использованием лит. данных рассчитаны значения $-\Delta H^0_{298}$ и ΔS^0_{298} образования тройных соединений, равные соотв.: Tl₂Sn₂S₅ $114,5 \pm 7,1$ ккал/моль и $14,8 \pm 3,0$ э. е., Tl₂SnS₃ $69,9 \pm 4,3$ и $12,4 \pm 2,6$, Tl₄SnS₄ $93,1 \pm 5,4$ и $22,8 \pm 4,2$, Tl₂Sn₂S₃ $81,9 \pm 4,2$ и $6,2 \pm 3,0$, Tl₄SnS₃ $80,8 \pm 4,8$ и $16,5 \pm 4,4$.

А. С. Гузей

ΔH^0_{298} ; ΔS^0_{298}

д'1980.13

1979

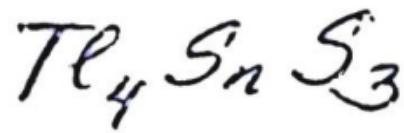
Tl₂Se-SnSe₂

91:79561u Study of the system thallium selenide-tin selenide (TlSe-SnSe₂). Gotuk, Ali Alarik; Babanly, M. B.; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Azerb. Khim. Zh.* 1979, (1), 153-5 (Russ). DTA, x-ray phase anal., and microhardness studies showed the TlSe-SnSe₂ system is of a quasi-binary section of the Tl-SnSe system. The solid state phase diagram of the Tl₂Se-SnSe₂-Se system was constructed.

изучение
твердого состояния

P.A.1074001N10

1979

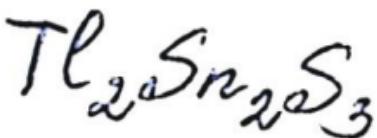


90: 193192d Phase equilibria in the thallium sulfide-tin sulfide (Tl_2S - SnS) system. Gotuk, Ali Alarik; Babanly, M. B.; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1979, 15(3), 530-1 (Russ). DTA, x-ray phase anal., and microhardness studies showed that the Tl_2S - SnS system is quasi-binary and contains Tl_4SnS_3 congruently m. at 350° and $\text{Tl}_2\text{Sn}_2\text{S}_3$ incongruently m. at 406° with eutectics at 345 , 345° and ~ 40 , ~ 60 mol% of SnS , resp.

(Tm)

C.A. 1979, 90, N24

79/79



13 б/44. Фазовое равновесие в системе Tl_2S-SnS .
Готук Али Аларик, Бабанлы М. Б., Кулев А. А. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1979,
15, № 3, 530—531

С помощью ДТА, РГА и измерения микротвердости исследовано фазовое равновесие в системе Tl_2S-SnS . Показано, что в ней образуются два промежуточных соединения: конгруэнтно плавящееся при 350° Tl_4SnS_3 (I) и инконгруэнтно плавящееся при 406° $Tl_2Sn_2S_3$. I претерпевает полиморфное превращение при 327° . В системе Tl_2S-SnS только на основе Tl_2S образуется заметная (~ 2 мол. %) область твердых растворов.

Автопечат

2.1979, N13

23 Б789. Фазовые равновесия в системе Tl—Sn—Te.
Готук Али Аларик, Бабанлы М. Б., Кулиев А. А. «Изв. АН СССР. Неорган. материалы», 1979,
15, № 8, 1356—1361

С помощью ДТА, РФА, а также измерения микротвердости сплавов исследованы фазовые равновесия системы Tl—Sn—Te по полигермич. разрезам $Tl_2Te-SnTe$, $TlTe-SnTe$, Tl_5Te_3-SnTe , Tl_2Te-Sn , Tl_4SnTe_3-Sn , Tl_4SnTe_3-Tl , Tl_4SnTe_3-Te , к-рые являются неквазибинарными. Установлено образование конгруэнтно плавящегося (555°) Tl_4SnTe_3 и инкогруэнтно плавящегося (370°) Tl_2SnTe_3 . Соединение Tl_4SnTe_3 изоструктурно с Tl_5Te_3 . Параметры тетрагон. решетки: a 8,89; c 12,41 Å. Система $Tl_5Te_3-Tl_4SnTe_3$ характеризуется неограниченной р-римостью компонентов как в жидк., так и в тв. состояниях. Построены проекция Пв ликвидуса и схематич. фазовая диаграмма при 25° системы Tl—Sn—Te. Показано образование значит. области тв. р-ров на основе Tl_4SnTe_3 , а также шести двухфазных и восьми трехфазных областей при 25° . Установлены конни и моновариантные равновесия в системе Tl—Sn—Te.

Автореферат

Tl_4SnTe_3
 Tl_2SnTe_3
фазов.
диагр.
(T_m)

х-1643, № 23

7949

Tl₃Sn₂Se₅

91: 63355u Study of the tin-thallium-selenium ternary system. Tin selenide (SnSe)-thallium selenide (TlSe) section. Houenou, Pascal; Eholie, Rose; Flahaut, Jean (Lab. Chim. Miner., Fac. Sci., Abidjan, Ivory Coast). *C. R. Hebdo. Seances Acad. Sci., Ser. C* 1979, 288(6), 193-5 (Fr). The SnSe-TlSe system is formed by the juxtaposition of the 2 quasi-binary systems SnSe-Tl₂SnSe₃ and Tl₂SnSe₃-TlSe. In these systems, the intermediate phases Tl₃Sn₂Se₅ and Tl₂SnSe₄ exist. Tl₃Sn₂Se₅ has a peritectic decomprn. at 490°, at the limit of the congruency; it forms a eutectic with Tl₂SnSe₃ at 444°. Tl₂SnSe₄ has a peritectic decomprn. at 360°. W. D. Smith

(Thm)



C.A. 1979, 91, N8

1979

Tl_xSnBi
n g . cb - fa
accmee

(all PbTlx; I)

Mamedov A.N.,

Ternodin. Svoistva Met.
Rasplavor, Mater. Vses.
Soveshch. Ternodin. Met.
Splavor (Rasplavy), 4th
1979, 2, 108-13.

1980

Tl_xTe - Tl_ySnTe₃

✓ 93: 156492t Thallium telluride-thallium tin telluride (Tl_xTe-Tl_ySnTe₃) polythermal cross section of a thallium-tin-tellurium system. Bahaly, M. B.; Gotuk, Ali Alarik; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1980, 16(8), 1486-7 (Russ). The phase diagram was constructed from DTA, microhardness, x-ray phase anal., and emf. data. The emf. data were obtained by using the cell (-)Tl(s)|glycerol + KCl, TlCl|(Tl_xSn_yTe_{3-x-y})(s)(+) at 300-430 K.

geszob.
guarfr.

$Tl_4SnTe_3 - Te$

1981

96: 149969n Thallium tin telluride-tellurium ($Tl_4SnTe_3 - Te$) section of a thallium-tin-tellurium ternary system. Babanly, M. B.; Gotuk, Ali Alarik; Kuliev, A. A. (Azerb. Gos. Univ., Baku, USSR). *Azerb. Khim. Zh.* 1981, (5), 98-100 (Russ). Phase equil. in the $Tl_4SnTe_3 - Te$ section was studied by emf., microhardness, DTA, and x-ray phase anal. methods. This section is non-quasibinary and contains 3 regions of 3-phase solid equil. Invariant equil. are listed for a wide range of Te concns.

99969 -
particelle

C.A. 1982, 96, N 18

$(\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x)_{1-y} \cdot \text{Te}_y$

1981

4 E492. Фазовый переход в сплавах $(\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x)_{1-y} \cdot \text{Te}_y$, легированных висмутом.

Джабус З. У., Шелимова А. Е., Санадзе В. В. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1981, 18, № 1, 29—32

Проведено дилатометрич. и рентгенографич. исследование сплавов $\text{GeTe}-\text{SnTe}$, легированных висмутом. Легирование висмутом уменьшает степень ромбоэдрического искажения низкотемпературной α -фазы, снижает температуру фазового перехода и величину скачка объема в точке фазового превращения $\alpha \rightarrow \beta$. Рассмотрена связь наблюдаемого при легировании висмутом увеличения коэф. теплового расширения α -фазы с изменением межатомных расстояний Te—Te в слое и между слоями.

Автореферат

Фазов. перех.

90. 1982, 18, № 4.

TlSn₂F₅)

1981

23 Б763. Ядерная релаксация ¹⁹F в ионном проводнике: TlSn₂F₅. Granier W., Bergier P., Dohgi M., Alizon J., Robert H. ¹⁹F nuclear relaxation in an ionic conductor: TlSn₂F₅. «J. phys. Lett.» (France), 1981, 42, № 13, 301—304 (англ.; рез. франц.)

Измерены времена спин-решеточной (T_1) релаксации ¹⁹F на частотах $\omega = 6,3; 16; 30$ и 80 МГц в соединении TlSn₂F₅ (I) в области т-р 233—423 К. Для этих образцов измерена электропроводность (σ) импедансным методом в диапазоне частот 5 Гц—500 КГц и т-р 233—403 К. В области $T < 358$ К зависимость $T_1 (T^{-1})$ имеет минимум при 323 К и падает с уменьшением ω . В низкот-рной области $T_1 \omega^{3/2}$. В окрестности $T_c = 358$ К значение T_1 резко возрастает при повышении т-ры. При $T > T_c$ время релаксации повышается с ростом т-ры и не зависит от ω . Полученные данные рассмотрены в рамках механизма диффузионного движения ионов, для к-рого энергия активации (E) составляет 0,30 и $0,19 \pm 0,02$ эВ при T — меньше и больше T_c соотв. Рез-

X. 1981, 19, N 23.

кий скачок на кривых T_1 (T^{-1}) и σ (T^{-1}) при $T \approx T_c$ связан с участием ионов F^- в диффузионном процессе, причем при низких т-рах диффузия ионов F^- осуществляется только по слоям в структуре I. Измерена энтальпия фазового перехода 1-го рода для I, к-рая составляет 520 ± 30 кал/моль; этому переходу соответствуют структурные изменения в I, сопровождающиеся значит. увеличением расстояния Sn—F. Отмечено, что этот фазовый переход можно рассматривать, как плавление анионной подрешетки, к-roe и приводит к увеличению σ до $5 \cdot 10^{-2}$ ($\Omega \cdot \text{см}$) $^{-1}$. В. П. Тарасов

1982

TlSn₂F₅

TlSnF₃ и др

T_m, T_{t2}, dR_m,
dP_{ta}

12 Б3134. Исследование бинарной системы TlF—SnF₂. Ионная проводимость, структура, термическая устойчивость полученных фаз. Contribution à l'étude du système binaire TlF—SnF₂. Conductivité ionique, structure, comportement thermique des phases rencontrées. Granier W., Vilminot S., Nabias G., Letof-
fe J. M., Claudio P. «Rev. chim. minér.», 1982, 19,
№ 1, 36—42 (фр.; рез. англ.)

С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии и дифрактометрии изучены фазовые соотношения в системе TlF (I)—SnF₂ (II). Образцы получены сплавлением I и α-II в запаянных золотых ампулах в инертной атмосфере при т-ре 210—300° С в течение 1—12 ч. Измерена ионная проводимость (ИП) образцов. Представлена фазовая диаграмма системы I—II, в к-рой образуются соединения TlSn₆F₁₃ (III), TlSn₂F₅ (IV), TlSnF₃ (V) и Tl₂SnF₄ (VI), а также две эвтектики при 14 и 47 мол.% I с т. пл. 181 и 188° С соотв.

X. 1984, 19, N 12

III разлагается в тв. состоянии при 170°C , энталпия разл.= $52,3\pm3,8$ кДж/моль. IV плавится конгруэнтно при 201°C (энталпия плавления $29,047\pm1,250$ кДж/моль) и претерпевает фазовое превращение при 84°C . V разлагается в тв. состоянии при т-ре $<188^{\circ}\text{C}$. VI плавится инконгруэнтно при 257°C . III — трикл., $P1$ или $\bar{P}1$: a 6,882(6); b 7,332(6); c 7,269(7) Å; α 93,97(2); β 91,67(2); γ 100,60(3); $Z=1$. IV — ромбоэдрич.; $P3m1$; a 4,269(4); c 10,248(9); $Z=1$; V — монокл., $P2_1c$; a 8,218(4); b 13,568(8); c 15,873(10) Å; β 113,0(6) $^{\circ}$; $Z=16$. ИП образцов связана с высокой поляризуемостью ионов.

Л. Г. Титов

Tl Sn₂ F₅

Tl Sn F₄

Tm;

1982

97: 116150f Thallium fluoride-tin(II) fluoride binary system. Ionic conductivity, structure, and thermal behavior of the observed phases. Granier, W.; Vilminot, S.; Nabias, G.; Letosse, J. M.; Claudy, P. (Lab. Chim. Miner. Appl. Chim. Mater., Ec. Natl. Super. Chim., 34075 Montpellier, Fr.). *Rev. Chim. Miner.* 1982, 19(1), 36-42 (Fr). The phase diagram was constructed from differential scanning calorimetric data. The compds. ($TlSn_6F_{13}$, $TlSn_2F_5$, $TlSnF_3$, and Tl_2SnF_4) were characterized by x-ray diffraction and ionic cond. measurements. Eutectics occur at TlF 14, 47 mol % and 181, 188°. Only $TlSn_2F_5$ melts congruently (201°); $TlSn_6F_{13}$ decomp. in the solid phase (170°) as does $TlSnF_3$ (near the eutectic temp. 188°); Tl_2SnF_4 incongruently m. 257°. Crystal lattice and thermodn. of fusion parameters are given.

c.A.1982, 97, N 14

SnTl₂S₄

1982

15 В4. Получение и рентгенографическое исследование тройного сульфида олова и таллия SnTl_2S_4 . Preparacion y estudio mediante difraccion de rayos X de un sulfuro ternario de estano y talio, SnTl_2S_4 . Gutierrez-Zoggilla J. M., Aggiortua M. I., Amigo J. M. «An. quim. Real soc. esp. quim.», 1982, B, епего—авг., 155—156 (исп.; рез. англ.)

Синтезирован SnTl_2S_4 из элементов при т-рах 650—700° С, определены хим. состав и плотность продуктов, образующихся ниже и выше этой т-рной области. Рентгенографически показано, что низкот-рной фазой является ромбич. соединение SnTl_2O_4 с параметрами решетки $a = 11,413(9)$, $b = 4,131(2)$, $c = 14,753(12)$ А, $Z = 4$.

Л. Абрамова

X. 1983, 19, N15.

Sn₂-TlY

1982

1 Б3039. Электрохимическое исследование расплава SnJ₂—TlJ. Electrochemical investigation on molten SnI₂—TlI system. Josiak Jerzy, Plinńska Stanisława. «Pol. J. Chem.», 1982, 56, № 1, 41—47 (англ.; рез. пол.)

В интервале т-р 625—743 К методом э. д. с. изучены термодинамич. св-ва 10 расплавов SnJ₂ (I)—TlJ в области составов от 0,25 до 0,95 мол. доли I. Вычислены и табулированы избыточные термодинамич. функции I в расплавах. Активность I в расплавах, найденная по электрохим. и криометрич. измерениям, совпадает. С привлечением лит. данных обсуждено влияние природы аниона на термодинамич. функции расплавов SnY₂—TlY, где Y=Cl⁻, Br⁻, J⁻. Отмечено, что наиболее значит. отриц. отклонения от идеальности наблюдаются в системах, содержащих бромид-ионы.

Б. В. Сергиевский

X. 1984, 19, N 1

Tl_2SnS_3

1984

Дюебаррий B. T.,
Старосея B. U. и др.

Teor. и эксперим. химия,
1984, 20, № 6, 787-788.

(см. $Tl_2Ge_2S_5$, I)

Tl₂SnS₃

1984

6 Б2018. Tl_2SnS_3 — тиостаннат с $[SnS_3^{2-}]_{\infty_1}$ цепочка-
ми. Tl_2SnS_3 — ein Thiostannat mit $[SnS_3^{2-}]$ -Ketten.
Клэр Курт О. «Monatsh. Chem.», 1984, 115, № 10,
1133—1142 (нем.; рез. англ.)

Проведен РСТА (автоматич. дифрактометр, λAg , ани-
зотропное приближение, 724 отражения, $R 0,127$) кри-
сталлов Tl_2SnS_3 (I), полученных нагреванием Tl_2S , Sn и
S, взятых в стехиометрич. соотношении, при 1050 К с
послед. охлаждением со скоростью 0,1 град./мин. Па-
раметры монокл. решетки I: $a 23,03$, $b 3,834$, $c 7,379$ Å,
 $Z 4$, ф. гр. $C2/m$. Основу структуры I составляют бес-
конечные цепочки (БЦ) $[SnS_3^{2-}]_{\infty_1}$, образованные объе-
дийнными по вершинам тетраэдрами SnS_4 . БЦ про-
стираются вдоль [010]. Расстояния $Sn-S$ 2,360—2,430,
 $Sn-Sn$ 3,834 Å, углы $SSnS$ 104,2—112,0°. Между БЦ
располагаются катионы Tl двух типов. Tl_1 координиро-
ван атомами S по типу двухшапочной тригон. призмы,
 Tl_2 заселяет центр искаженного куба, образованного
атомами S, расстояния Tl_1-S 3,129—3,941, Tl_2-S
3,285—3,409 Å. Проведено сравнение I со структура-
ми соединений, в к-рых существуют БЦ. Для I при-
ведены данные I , $d(hkl)$.

В. Б. Калинин

X.1985, 19, N 6

Тl₄SnS₄

1984

17 Б2029.. Кристаллическая структура Tl₄SnS₄. Structure cristalline de Tl₄SnS₄. Pittard Yves, Tougnoux Michel, Ajavon Ayité-Lô, Ehlié Rose. «Rev. chim. minér.», 1984, 21, № 1, 21—27 (фр.; рез. англ.)

Осуществлен синтез (взаимодействием элементов в вакууме при 600°С) и рентгенографич. исследование (λ Mo, анизотропный МНК, R 0,060 для 1451 отражений) кристаллов Tl₄SnS₄. Параметры монокл. решетки: *a* 8,357, *b* 8,246, *c* 15,334 Å, β 103,69°, *r*_{нэм} 6,89, *ρ* (выч.) 6,91, *Z* 4, ф. гр. *P*2₁/c. Атомы Sn в структуре находятся в тетраэдрич. координации из атомов S (Sn—S 3,063—3,557 Å). Тетраэдры SnS₄ изолированы друг от друга и связаны атомами Tl, находящимися в неправильной координации из 5 и 6 атомов S (Tl—S 2,981—3,759). Отмечено влияние на координацию Tl собственной неподеленной пары электронов.

С. В. Соболева

Кристал.
Структура

Х. 1984, 19, N 17

Tl₄Sn₅S₁₂

1984

16 Б2031. Кристаллическая структура $Tl_4Sn_5S_{12}$. Structure cristalline du $Tl_4Sn_5S_{12}$. Piffard Yves, Tournoux Michel, Ajavon Ayité-Lô, Eholié Rose. «Rev. chim. minér.», 1984, 21, № 1, 56—66 (фр.; рез. англ.)

Синтезированы (взаимодействием элементов в вакууме 10^{-3} Торр при т-ре $600^\circ C$) и рентгенографически изучены (λ Mo, анизотропный МНК, R 0,051 для 2827 отражений) кристаллы $Tl_4Sn_5S_{12}$. Параметры трикл. решетки: a 17,085 Å, b 7,355, c 9,639, α $67,23^\circ$, β $75,05^\circ$, γ $89,79^\circ$, ρ (изм.) 5,55, ρ (выч.) 5,57, Z 2, ф. гр. $P1$. Атомы Sn находятся в структуре в 3 типах координации: тетраэдрич. (Sn—S 2,366—2,433 Å), октаэдрич. (Sn—S 2,507—2,618) и необычной для Sn 5-кратной в виде полуоктаэдра (Sn—S 2,436—2,622), дополненной еще одним атомом S (Sn—S 2,988) до сильно искажен-

*Кристал.
Структура*

X.1984, 19, № 16

ного октаэдра. Многогранники вокруг Sn соединяются вершинами и ребрами в трехмерный каркас, пронизанный в направлении оси *b* каналами большого сечения, в к-рых размещаются атомы Tl в окружении из 7—9 атомов (Tl—S 3,008—3,727). С. В. Соболева

Tl₄SnSe₄

1985

и др.

П_m, П_{t2}

) 20 Б3140. Фазовые равновесия и свойства соединений в системах Tl₂S(Se)—SnS₂(Se₂). Лазарев В. Б., Переш Е. Ю., Староста В. И., Мудрый В. В. «Ж. неорган. химии», 1985, 30, № 6, 1502—1506

Методами физ.-хим. анализа исследованы фазовые равновесия в системе Tl₂Se—SnSe₂. Установлено существование соединений Tl₄SnSe₄ и Tl₂SnSe₃, плавящихся конгруэнтно при 718 и 735 К соотв. и Tl₂Sn₂Se₅, к-ое образуется при 655 К и перитектически разлагается при 732 К. Соединение Tl₂SnSe₃, по данным ДТА, при 710 К претерпевает полиморфное превращение. Определены области гомогенности нек-рых соединений, образующихся в системах Tl₂S(Se)—SnS₂(Se₂). Методом Бриджмена—Стокбаргера выращены монокристаллы соединений Tl₄SnS₄(Se₄) и Tl₂SnS₃(Se₃), на к-рых исследованы нек-рые св-ва: определены плотность и уд. со- противление, сняты спектры пропускания и фотопроводимости.

Резюме

Х. 1985, 19, № 20

Tl₄SnSe₄

1985

103: 60127b Phase equilibrium and properties of compounds in Tl₂S(Se)-SnS₂(Se₂) systems. Lazarev, V. B.; Peresh, E. Yu.; Starosta, V. I.; Mudryi, V. V. (Uzhgorod. Gos. Univ., Uzhgorod, USSR). *Zh. Neorg. Khim.* 1985, 30(6), 1502-6 (Russ). Phase equil. was studied by DTA, microhardness, microstructural, and x-ray phase anal. methods. The compds. Tl₄SnSe₄ and Tl₂SnSe₃ congruently m. 718, 735 K, resp., and Tl₂Sn₂Se₅ forms at 655 K and incongruently.

Tm;

m. 732 K. A polymorphic transition of Tl₂SnSe₃ occurs at 710 K. Single crystals of Tl₄SnS₄(Se₄) and Tl₂SnS₃(Se₃) were grown by the Bridgman-Stockbarger method and their ds., sp. resistances, transmission spectra, and photoconductivities were detd.

Tl₂SnSe₃

(Tm, Ttr)

C. A. 1985, 103, N8.

$Tl_y Sn_3 S_4$; $Tl_2 Sn_3 S_3$; 1985
 $Tl Sn_2 Se_y$ Терещук Е. ГО., Назарев В. Ф. и гр
у гр.
меркури- 9 Всес. совещ. по мерку-
зрати- арии., Ункзорог, сентябрь,
иимпури. 1985. Тез. докт. Курев, 1985,
иис.илг. 176-177.

(ав. $Tl_y Si_3 S_4$ у гр.; I)

Tl_xSnSe₄ u gp.

1985

Тепеш Е.Ю., Лазарев В.Ф. u gp.

мерку- 9 Всес. совещ. по мерку.
зрату- Акад., Ученорог, сим.,
иемур. 1985. Тез. докт. Куб, 1985,
Уссурийск. 176-177.

(cer.Tly Si Sy u gp.; I)

Tl_2SnS_3

1985

Тепесев Е.Ю., Назарев В.Ф. и др.

мерку- 9 Всес. совещ. по мерку.
зраби- АМОИ., Ункюров, Симон.,
шемпур. 1985. Тез. конф. Кург, 1985,
Ученег. 176-177.

(c.u. Tl_2SiS_4 и др.; ?)

SnTl₂SeTe

1986

/105: 30825b Tin(II) telluride-indium selenide and tin(II) telluride thallium selenide systems. Ashirov, A.; Gurshumov, A. P.; Dovletov, K.; Mamedov, N. A. (Fiz.-Tekh. Inst., Ashkhabad, USSR). *Zh. Neorg. Khim.* 1986, 31(5), 1282-4 (Russ). Physicochem. methods were used to study the title systems and to construct their phase diagrams. The SnTe-Tl₂Se is quasibinary with limited regions of solid solns. and one incongruently m. compd. The compd. SnTl₂SeTe is formed by a peritectic reaction at 450°. The eutectic contains 86 mol.% Tl₂Se and m. at 350°. In the SnTe-InSe system, at 0-60 mol.% InSe solid solns. based on SnTe are formed. The compd. SnInTeSe sep. at 50-70 mol.% InSe. This compd. is formed by a peritectic reaction in the regions 2-49 and 51-98.5 mol.% InSe, at 500°. Solubilities of the components in the solid solns. are limited.

(T_m)

c. A. 1986, 105, NY

Cuernavaca Om. 24917 1986

$\text{SnS}_2\text{-Tl}_2\text{S}$ Ibanez A., Jumas J.-C.,
Philipot E., et al.,

Rev. Chim. Miner., 1986,
23, N3, 281-289.

Пл. SnSe₂
Пл. SnSe₃

1986

6 Б3089. Система SnSe—TlSe. Мургузов М. И.,
Гуршумов А. П., Ахмедов А. М., Алиджанов М. А.,
Сафаров Д. М., Наджафова С. С. «Ж. неорган. хи-
мии», 1986, 31, № 12, 3097—3100

Методами ФХА изучено фазовое равновесие в си-
стеме SnSe—TlSe и построены диаграммы состояния.
Установлено образование соединений TlSnSe₂ и Tl₂Sn-
Se₃, плавящихся инконгруэнтно. TlSnSe₂ относится к
моноclinиной (a 10,86, b 10,64, c 15,53 Å, γ 101,60°),
Tl₂SnSe₃ — к ромбич. сингонии (a 8,05, b 8,17, c
21,24 Å).

Резюме

Пл.

Х. 1987, 19, N 6.

РЛ-Ш Лот. 25338 1986

Персив Е.Ю., Лазарев В.Б.,
Старостина В.И.,

УЗб. АН СССР. Недораз.

журн., 1986, 22, N 12,

1967-1971.

ТМ, 1 км

ПЛ-Си

Лм. 25338

1986

Петров Е.Ю., Лагарев В.Б.,
Смирнова В.И.,

Лм, АМи

Уф. АН СССР. Издат. нау-
чен., 1986, 22, № 12,
1967 - ● 1971.

$TlSnPS_4$

1987

108: 105150a Crystal structure and vibrational spectrum of thallium tin thiophosphate ($TlSnPS_4$). Becker, Robert; Brockner, Wolfgang; Eisenmann, Brigitte (Inst. Anorg. Chem., Tech. Univ. Clausthal, D-3392 Clausthal-Zellerfeld, Fed. Rep. Ger.). *Z. Naturforsch., A: Phys. Sci.* 1987, 42(11), 1309-12 (Ger). $TlSnPS_4$ was prep'd. from the elements at 800°. It crystallizes in the orthorhombic system, space group $Pna2_1$, $Z = 4$, a 1175.8(5), b 890.1(4), c 663.3(4) pm. In the structure are slightly distorted discrete PS_4^{3-} anions. The IR, Raman and Raman spectra are assigned on the basis of PS_4^{3-} units with C_{3v} symmetry. According to the DTA data the m.p. for $TlSnPS_4$ is $575 \pm 5^\circ$. $TlSnPS_4$ is not moisture-sensitive and semiconducting.

Tm

C.A. 1988, 108, n12

Pl₂SnS₃

Pl₂SnSe₃

1988

9 Б3052. Фазовые равновесия в системе Tl_2SnS_3 — Tl_2SnSe_3 / Переш Е. Ю., Староста В. И. // 7 Всес. совещ. по физ.-хим. анал., Фрунзе, 4—6 окт., 1988: Тез. докл.— Фрунзе, 1988.— С. 427—428.— Рус.

С помощью ДТА, РФА, измерения микротвердости изучено равновесие в системе Tl_2SnS_3 (I) — Tl_2SnSe_3 (II). Оба соединения плавятся конгруэнтно при 699 К (I) и 735 К (II). Показано, что диаграмма состояния системы I—II эвтектич. типа с ограниченными обл. тв. р-ров на основе исходных в-в. Эвтектика — при 685 К и 50 мол. % I. На основе высокот-рной и низкот-рной модификации II обнаружена обл. тв. р-ров, к-рая при эвтектич. т-ре не превышает 15 мол. % и резко уменьшается при понижении т-ры (не более 5 мол. % при 523 К). В отличие от II на основе I существует довольно обширная обл. тв. р-ров — до 30 мол. % при 685 К и до 25 мол. % при 523 К.

По резюме

Tm

X. 1989, № 9

МЛ5 ЗН3

1988

№ 4 БЗ161 ДЕП. Скорость испарения и давление пара
 Ti_5Sn_3 / Подаревская О. В., Фесенко В. В., Три-
лис О. Ю., Тимохин В. В.; Киев. технол. ин-т пищ.
пром-сти.— Киев, 1988.— 4 с. Библиогр.: 2 назв.—
Рус.— Деп. в УкрНИИНТИ 27.10.88, № 2752—Ук88

Исследование скорости испарения станида титана (I) проведено на высоковакуумной высокот-рной испарительной установке в интервале т-р 1465—1755 К. Скорость испарения определялась по убыли веса образца, давление пара — эффузионным методом Кнудсена. Полученные т-рные зависимости скорости испарения ($\text{кг}/\text{м}^2 \cdot \text{с}$) исследуемого соединения и давл. пара (Па) олова над ним аппроксимируются ур-ниями: $\ln G = -[(4,487 \pm 0,113) \cdot 10^4 T^{-1} - (20,053 \pm 0,687)]$ (1), $\ln P = -[(4,572 \pm 0,110) \cdot 10^4 T^{-1} - (27,321 \pm 0,672)]$ (2). В пределах ошибки эксперимента не замечено влияние изменения площади эффузионного отверстия на скорость испарения I. Станд. теплота образования I с учетом станд. теплоты сублимации олова равна $37,217 \pm 4,184$ кДж/моль.

Автореферат

($P, K_f, A f_f$)
Х.1989, № 4

TlSnSe₂
Tl₂SnSe₃

1989

20 Б3030 Деп. Термодинамические свойства TlSnSe₂ и Tl₂SnSe₃ / Гуршумов А. П., Аббасов А. С., Ализаде М. З.; Ин-т неорган. и физ. химии АН АзССР.— Баку, 1989.— 6 с.: ил.— Библиогр.: 3 назв.— Рус.— Деп. в ВИНИТИ 11.07.89, № 4560—В89

Методом измерения э.д.с. в интервале т-р 320—450 К проведено термодинамич. исследование системы SnSe—TlSe. Подтверждена диаграмма состояния, построенная авторами ранее методами ДТА, РФА и измерения микротвердости. Рассчитаны станд. термодинамич. ф-ции образования TlSnSe₂ и Tl₂SnSe₃ из тв. элементов: $-\Delta_fH_{298}^{\circ} 127,91 \pm 14,11$ и $157,08 \pm 17,20$ кДж/моль; $-\Delta_fS^{\circ} 9,37 \pm 2,62$ и $19,23 \pm 4,18$ Дж/моль·К; $S^{\circ} 183,66 \pm 2,62$ и $280,39 \pm 4,18$ Дж/моль·К; $\Delta_aH 982,6$ и $1379,3$ кДж/моль.

А. Л. М.

X. 1989, № 20

Tl₂Te - SnTe

1990

J 21 Б3093. Фазовая диаграмма системы Tl₂Te—SnTe.
Phase diagram for the Tl₂Te—SnTe system / Gawel W.,
Zaleska E., Maskiewicz E. // J. Therm. Anal.— 1990.—
36, № 7—8.— С. 2323—2327.— Англ.; рез. нем.

Методами термич. анализа кривых охлаждения и
ДТА изучены фазовые соотношения Tl₂Te (I)—SnTe
(II). Представлены фазовая диаграмма системы I—II,
в к-рой образуется соединение с составом I : II = 2 : 1
(33,3 мол. % II) и т. пл. $546,1 \pm 0,5^\circ\text{C}$ (конгруэнтно).
Это соединение образует непрерывные тв. р-ры с I, а
с II образует эвтектику при $51,4 \pm 0,5$ мол. % II с т. пл.
 $515,3 \pm 0,5^\circ\text{C}$. Т. пл. II $800,0 \pm 0,5^\circ\text{C}$. Л. Г. Титов

III

X. 1991, N 21

РадиоРес

1991

20 Б2032. Структура Tl_2SnTe_5 . Structure of Tl_2SnTe_5
Agafonov V., Legendre B., Rodier N., Cense J. M., Dichi E., Kra G. //Acta crystallogr. C.—1991.—47, № 4
—С. 850—852.—Англ.

Методом РСТА (294 К, λ Mo, 236 независимых отражений, 294 К, $R = 0,041$) изучено строение тетрагонального Tl_2SnTe_5 (I), полученного в эвакуир. ампуле из эл-тов при 543 К. Для I $a = 8,306$, $c = 15,161$ Å, $Z = 4$, ρ (выч.) 7,40, ф. гр. I $4/mcm$. Структура, как и CT Tl_2GeTe_5 (II), построена из тетраэдров $SnTe_4$ (T) и квадратно-планарных группировок $TeT_4(S)$ с $Sn—Te = 2,792$ и $Te—Te = 3,004$ Å, связанных между собой полиздрами атомов Tl, представляющими собой кубы. (C) или тетрагональные антипризмы (A). Расстояния $Tl—Te = 3,491—3,663$ Å, $Tl—Tl = 3,790$ Å. В I тетраэдры и квадраты образуют цепочки, тянувшиеся вдоль [001], однако в отличие от II последовательность полиздров в цепочках T—S—T—S. Цепочки связаны полиздрами атомов Tl в отличие от II с последовательностью A—C—A—C.

М. Б. Варфоломеев

X. 1992, № 20

Tl₂Te - SnTe (aux)

1991

116: 159968g Thermodynamic properties of the thallium telluride-tin telluride (Tl₂Te-SnTe) molten system. Zaleska, Ewa; Malachowicz, Grzegorz (Dep. Inorg. Chem., Sch. Med., 50139 Wroclaw, Pol.). *Pol. J. Chem.* 1991, 65(7-8), 1351-5 (Eng). Thermodn. data for the liq. phase of the Tl₂Te-SnTe system were derived by concn. cell emf. measurements. The dependence of partial molal thermodn. functions of thallium on the compn. of the liq. and solid phases of the system is discussed.

MEASUREMENTS
GATHERED

C.A. 1992, 116, N16

R₄SnTe₃

1991

10 Б3067. Термодинамические свойства расплавленной системы Tl₂Te—SnTe. Thermodynamic properties of the Tl₂Te—SnTe molten system / Zaleska Ewa, Małachowicz Grzegorz // Pol. J. Chem.— 1991.— 65, № 7—8.— С. 1351—1355.— Англ.; рез. пол.

Методом э. д. с. при т-рах 698—1123 К изучены термодинамич. св-ва жидк. фазы псевдобинарной системы Tl₂Te—SnTe. Найдено, что в тв. фазе этой системы компоненты образуют соединение Tl₄SnTe₃, конгруэнтно плавящееся при 819 К. Обсуждена зависимость парц. молярных термодинамич. ф-ций таллия от состава жидк. и тв. фаз исследованной системы.

В. Ф. Байбуз

X. 1992, N 10

Tl₄SnSe₃

1992

) 20 Б3049. Установление существования нового соединения в системе Tl—Sn—Se: Tl₄SnSe₃. Mise en évidence d'un nouveau composé du système Tl—Sn—Se: le composé Tl₄SnSe₃ /Akincho Gérard, Houenou Pascal, Oyetola Samuel, Eholie Rose, Olivier-Fourcade Josette, Jumas Jean-Claude, Maurin Maurice //C. r. Acad. sci. Ser. 2 .—1992 .—314 , № 12 .—С. 1313—1317 .—Фр. ;рез. англ.

С помощью РГА, мессбауэровской спектроскопии (¹¹⁹Sn) изучено вз-вие в системе Tl—Sn—Se. Установлено существование Tl₄SnSe₃ (I). I изоструктурен Tl₄SnS₃, кристаллизуется в тетрагон. сингонии, пр. гр. P4/ncc; а 8,57, с 12,74 Å; Z=4. Показано, что в крист. решетке SnII имеет октаэдрич. координацию.

Б. Г. Коршунов

структура

X. 1992, N 26

Tl₃SnI₅

1992

и гр.

12 Б3086. О новом исследовании фазовой диаграммы [системы] TII—SnI₂. Zur Neuuntersuchung des Phasendiagramms TlI—SnI₂ /Stöwe K., Beck H. P. //Z. anorg. und allg. Chem. — 1992 .— 608 , № 2 .— С. 119—122 .— Нем. ;рез. англ.

Методами рентгенографии и ДТА изучены фазовые соотношения в системе TII (I)—SnI₂ (II). Представлена фазовая диаграмма системы I—II, в к-рой образуются три соединения: Tl₃SnI₅, TlSnI₃ и TlSn₂I₅ с т. пл. 329, 292 и 307° С соотв. (все — конгруэнтно), а также ранее неизвестная фаза Tl₄SnI₆ с т. разл. 229° С. Т. пл. I и II 442,7 и 322,4° С соотв. Т-ра перехода жел. I в красн. 188,7° С. В системе образуются три эвтектики с т. пл. 286,4, 292,1 и 287,8° С соотв. при мол. доле II 0,425, 0,55 и 0,79 соотв. Приведены параметры решеток полученных фаз.

Л. Г. Титов

X. 1993, N 12

Tl_2SnI_5
 $TlSnI_3$
 $TlSn_2I_5$

(T_m)

PG.92

116: 2019S1h Redetermination of the thallium(I+) iodide-tin(2+) iodide phase diagram. Stoewe, K.; Beck, H. P. (Fachrichtung Anorg. Anal. Chem. Radiochem., Univ. Saarlandes, D-6600 Saarbruecken, 11 Germany). Z. Anorg. Allg. Chem. 1992, 605, 119-22 (Ger.). A reinvestigation of the phase diagram $TlI-SnI_2$ revealed the existence of a not yet known ternary 4:1 compd. of the formula Tl_4SnI_6 , which decompns. peritectoidally at 229°C. The congruent m.ps. of the other three ternary compds. in the system, Tl_2SnI_5 , $TlSnI_3$, and $TlSn_2I_5$, at 329, 292 and 307°C, resp., agreed well with former specifications. The polymorphic transitions of the compds. Tl_2SnI_5 and $TlSn_2I_5$ described by other authors could not be verified.

C.A.1992, 116, N20

F: Tl-Sn-Te

P: 1

1999

131:303572 Local electronic structure of Tl-Sn-Te compounds. Lippens, P. E.; Aldon, L.; Olivier-Fourcade, J.; Jumas, J. C.; De la Rocque, A. Gheorghiu; Senemaud, C. Laboratoire de Physicochimie de la Matiere Condensee (CNRS UMR 5617), Universite Montpellier II Montpellier F-34095, Fr. J. Phys. Chem. Solids, 60(10), 1745-1754 (English) 1999 The combined application of Moessbauer spectroscopy and XPS provides a consistent picture of the local electronic structure in Tl₅Te₃, TlTe, Tl₂Te₃, Tl₄SnTe₃ and Tl₂SnTe₅. The results are discussed from a tight-binding calcn. of the electronic populations. Values of the Tl 4f_{7/2} cor level binding energy do not vary noticeably for the different compds. in agreement with the close values of the calcd. Tl av. charges. The

result obtained by both the XPS and ^{125}Te Moessbauer spectroscopy are consistent with the existence of two types of Te atoms with very different at. charg due to the differences in the no. of Te 5p electrons. The variations of the Te charge are explained from changes in the nature of the Te nearest neighbors: Tl, Sn and Te as a function of the stoichiometry. Finally, values of the ^{119}Sn Moessbauer isomer shift and the Sn 4d5/2 core-level binding energy both increase from Tl_2SnTe_5 to Tl_4SnTe_3 in agreement with the increase of the calcd. no. of Sn 5s electrons and the decrease of the calcd. no. of Sn 5p electrons, resp. These changes are related to the differences between the Sn local environments of the two ternary compds.